

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

テーマ「フロントエンドプロセス」

〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）

日時 平成20年5月14日（水）13:00～16:30

場所 東京工業大学 百年記念館 3階フェライト会議室（〒152-8550 目黒区大岡山2-12-1, 東急東横線にて自由が丘駅下車，東急大井町線へ乗換えて大岡山駅下車，JR京浜東北線大井町駅下車，東急大井線に乗換えて大岡山駅下車，詳しいアクセスは下記URLをご参照下さい。

<http://www.titech.ac.jp/access-and-campusmap/j/o-okayama-campus-j.html>)

委員会開催にあたって

徳光永輔（東京工業大学）…………… 1

EFM-08-1 Ru-Mo合金を用いた金属/high-k絶縁膜ゲートスタックの実効仕事関数制御

大毛利健治（早稲田大学，物質・材料研究機構）

知京豊裕（物質・材料研究機構）

細井卓治，渡部平司（大阪大学）

中島清美，足立哲也，石川恵子（物質・材料研究機構）

杉田義博，奈良安雄，大路 譲（半導体先端テクノロジーズ）

白石賢二，山部紀久夫（筑波大学）

山田啓作（早稲田大学）…………… 3

EFM-08-2 HiSiON/TiNゲートスタックpMOSFETの陰極電子注入絶縁破壊モデルに基づくTDDB寿命予測方法

佐藤基之，青山敬幸，奈良安雄，大路 譲（半導体先端テクノロジーズ）

蓮沼 隆，山部紀久夫，白石賢二（筑波大学）

宮崎誠一（広島大学）

山田啓作（早稲田大学）…………… 7

- EFM-08-3 混載メモリ応用へ向けた相制御 Ni-FUSI/HfSiON ゲートスタックの
インテグレーション技術
西藤哲史, 増崎幸治, 高橋健介,
砂村 潤, 間部謙三, 辰巳 徹, 渡辺啓仁 (日本電気)
小倉 卓, 白井浩樹 (NECエレクトロニクス) …… 13
- EFM-08-4 Ge 表面酸化および窒化処理と High-k ゲートスタック構造形成プロセス
近藤博基, 坂下満男, 中塚 理, 小川正毅, 財満鎮明 (名古屋大学) …… 17
- EFM-08-5 Si 原子層により終端された Ge MIS 界面特性とその反転層正孔移動度への影響
田岡紀之 (半導体 MIRAI-ASRC)
原田真臣, 山下良美, 山本豊二, 杉山直治 (半導体 MIRAI-ASET)
高木信一 (東京大学, 半導体 MIRAI-ASRC) …… 23

協 賛 機能性誘電体薄膜先端技術調査専門委員会